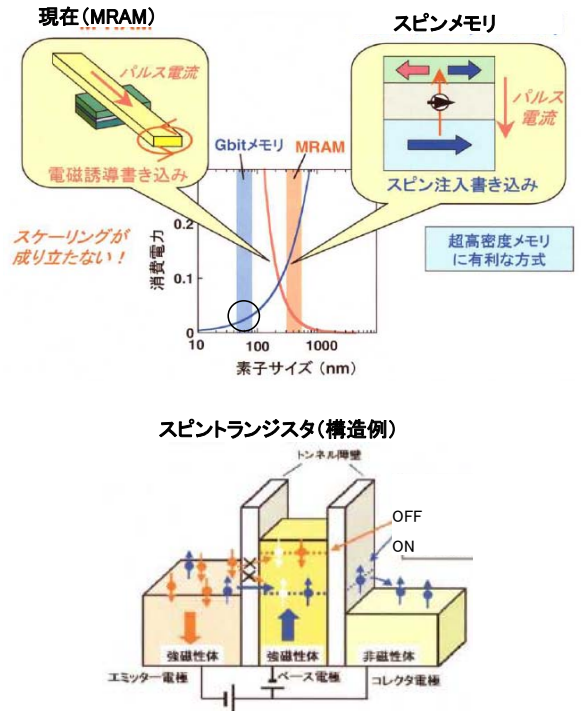


施策名：スピントロニクス不揮発性機能技術プロジェクト【経済産業省】

平成20年度対象予算： 520百万円
 (平成19年度対象予算： 650百万円)
 実施期間： 平成18～22年度
 (予算総額： 3,050百万円)

○次世代不揮発性半導体メモリ(RAM)、ストレージデバイス、論理素子などの実現のために、強磁性金属ナノ構造体中のスピン(ナノサイズ磁石)を、電流や光で直接制御する技術を確認する。
 ○これにより新しい高性能不揮発性デバイスの実現のための基盤技術を確認する。

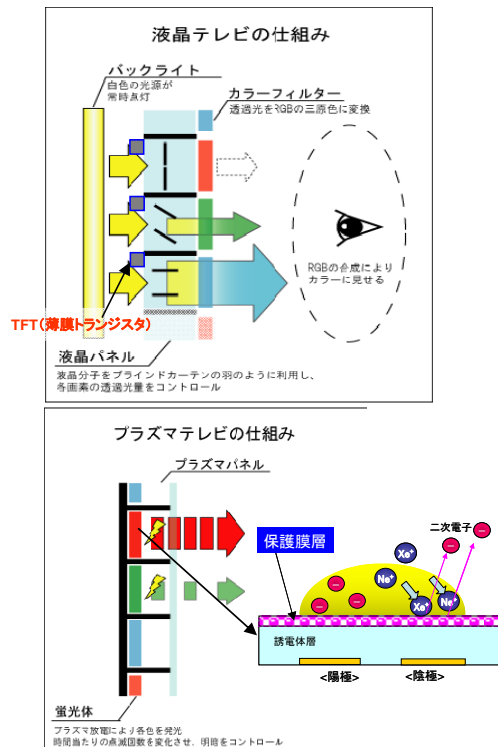
- ・ギガビットを超える大容量を持つ夢の不揮発性メモリ(スピンRAM)
- ・システムLSIに混載可能でSRAMを置き換えることの出来る高速新型不揮発性メモリ
- ・機械的回転機構が無く高耐衝撃性・高速・低消費電力の特長を持つモバイル用新型ストレージデバイス
- ・光情報の高速読み書きが可能な導波路型不揮発性光メモリ
- ・不揮発性と論理機能を単一のデバイスで実現するスピントランジスタ



施策名：次世代大型低消費電力ディスプレイ基盤技術開発【経済産業省】

平成20年度対象予算： 1,173百万円
 (平成19年度対象予算： 1,235百万円)
 実施期間： 平成19～23年度
 (予算総額： 5,927百万円)

○次世代の大型液晶及び大型プラズマディスプレイに関する低消費電力ディスプレイを実現するための研究開発を行う。
 ○液晶に関しては、高効率バックライト、革新的なTFTアレイプロセス技術・製造装置及び低消費電力型の画像処理エンジン等に係る技術の開発を行う。
 ○プラズマに関しては、超低電圧駆動等に係る技術の開発を行う。



施策名: グリーンITプロジェクト【経済産業省】

平成20年度対象予算: 3,000百万円
(平成20年度新規)
実施期間: 平成20~24年度
(予算総額: 15,000百万円)

OIT化の進展により、ネットワークを流れるデータ量が大幅に増加する中で、IT機器による消費電力量の大幅な増大に対応し、環境調和型IT社会の構築を図るため、個別のデバイスや機器に加え、ネットワーク全体での革新的な省エネルギー技術の開発を行う。

